

科学研究費助成事業 研究成果報告書

令和元年6月15日現在

機関番号：34416

研究種目：基盤研究(B) (一般)

研究期間：2016～2018

課題番号：16H04521

研究課題名(和文) セラミック半導体の光応答を利用した細胞培養デバイスの開発

研究課題名(英文) Development of cell culture device utilising light response of ceramic semiconductor

研究代表者

上田 正人 (Ueda, Masato)

関西大学・化学生命工学部・教授

研究者番号：40362660

交付決定額(研究期間全体)：(直接経費) 12,400,000円

研究成果の概要(和文)：光応答セラミックスを利用して、細胞の基盤への接着を酵素処理フリーで制御することを目的とした。TiO₂とSrTiO₃は、バンドギャップが3.0-3.2 eVのn型半導体であり、紫外光(UV)照射で光触媒反応を呈する。そのセラミックスをSiO₂上にRFスパッタリングで成膜した。その表面では暗所下で細胞が単調に増殖した。その表面にUV予備照射を施すと細胞接着が促進された。逆に連続照射を行うとその接着は抑制された。なお、UVは同膜で完全に吸収されるため、細胞はUVに曝されない。これらは、細胞の接着・増殖・剥離挙動をこの細胞培養器で制御できることを示している。さらに、細胞の2次元配置も可能となった。

研究成果の学術的意義や社会的意義

紫外線(UV)に応答するTiO₂とSrTiO₃をSiO₂基盤上に成膜したシンプルな構造を有する細胞培養器を開発し、光照射によって細胞接着の促進や抑制を制御できることを実験的に示した。なお、UV照射は培養器背面から行い、細胞はUVに曝されない構造とした。これは、細胞にダメージを与えてしまう従来の酵素処理を用いた細胞制御に代わる有効な手法である。さらに、細胞の2次元配置も可能となった。本技術を利用すれば、複数の細胞を任意に配置した細胞シートを作製することが可能となる。

研究成果の概要(英文)：Attachment/detachment of cells to/from substrates was tried to control without enzyme treatments by using photo-responsible ceramic films and light irradiation. TiO₂ and SrTiO₃ are n-type semiconductors with an energy band gap of 3.0-3.2 eV, which display photocatalytic reactions under ultraviolet (UV). Such films were prepared on SiO₂ by a RF sputtering. Basically the number of cells monotonically increased with incubation periods under darkness. Previous UV irradiation promoted the cell adhesion. In contrast, the cells decreased under continuous UV irradiation. The cells were not exposed to UV in the vessels since it was completely absorbed by the ceramics layer. These results indicate that the adhesion/proliferation/detachment behaviours of cells can be controlled by the photocatalytic reactions of ceramic films and the irradiation patterns. Furthermore, two-dimensional patterning of attached cells by light irradiation could be performed in the vessels with simple structure.

研究分野：材料物性学

キーワード：生体材料 セラミックス 光化学反応

GC(9pM+6&Q)E
 rS<(K0W76K%TV
 IO4y6&IO'A
 N8b0vN#KSvb58Nw9x(KZ
 6&S
 A(MGamb0ZImA18E
 Cb%E@FSu38WQe807GM
 87W2b0vDx7)D@G@
 %KK(808
 6&KS%EcE
 80x(66
 #KS9x66Sc
 G8wmbE

37°C 8KS* 20> 25°C XG#ce

2, 2004, 83-92 ^

4524390Pbp)i

ubL7&U8=

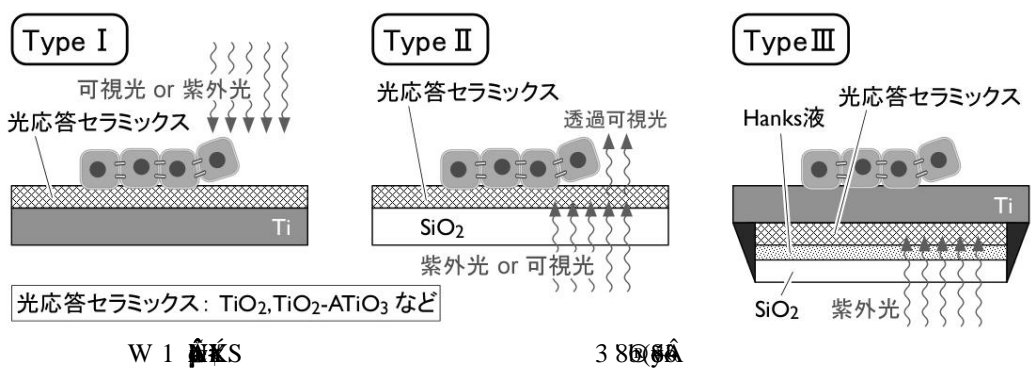
2 80b(ry

0,%Eb% \$

M
 TiO₂ S
 5D
 H(δ † /αWS

(iii) (K%Tò 3 80&A WZK0DM

G \ % \ K S 6o (i) ”
 b 80 &W>1> (ii) α
 m2 b



□ 2

3.1

Type 2 Type E
 P@ 20 min *KS* 1 M NH₃ E@ 180°C-12 h bMIGBKS
 Typeé E• TiO₂ wc* Ti(OC₃H₇)₄ NKS M^ Sol-gel 2 (ç Ti ê
 # Ar-O₂ 6&v5š 8:5P×GWZ BKS Qw
 673> 873 K b&WIOS

3.2

3.2.1

(ç Ti (ç Nb KS 2 WZ (Ti_{1-x}Nb_x)O_{2-δ}
 Ti8 Nb = 18 1> 0.25 IOS

3.2.2

(ç Ti † 5 M H₂O₂/0.1 M HNO₃ P@X8_ TiO₂ gel wBKS* Sr(OH)₂ È
 P@KS# 673> 873 K b KS* 1 M HNO₃ E@ |
 • Sr b 6&KS

3.3

TypeéV% Typeé Type
 † K Z a KS
 r S> WST 2 _ | • (X b 0U v/WS I } _ S&gA0PKS

